

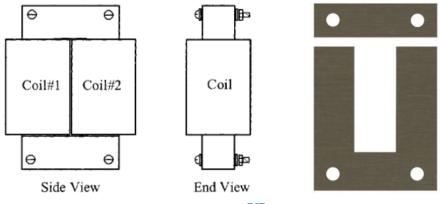


هدف از این قسمت شبیه سازی مدار مغناطیسی یک ترانسفورماتور و یافتن مدار معادل آن است. شبیه سازی مدارمغناطیسی در نرم افزار MATLAB و بخش SIMULINK آن انجام می شود.

قصد داریم یک ترانسفورماتور تکفاز V/40 V/40 طراحی کنیم. فراموش نکنید که زمانی که از یک ولتاژ در مهندسی قدرت صحبت می شود منظور مقدار موثر ولتاژ است. ترانسفورماتور طراحی شده را قرار است از برق شهر تغذیه کرده و در سمت دیگر یک مجموعهای که با ولتاژ v/40 با مقدار موثر v/40 کار می کند را راهاندازی کنیم.

انتخاب شكل هسته:

برای ساخت این ترانسفورماتور به سراغ هستههای UI رفتهایم. نمونه این هسته و فرم نهایی ترانسفورماتوری که قرار است ساخته شود در شکل ۱ نمایش داده شده است.

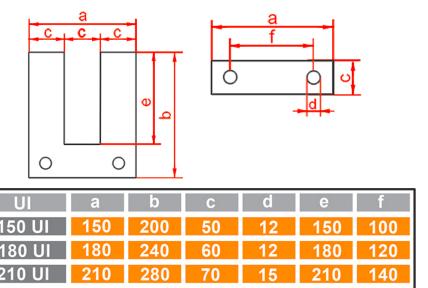


شکل ۱: تصویر هسته UI و شکل نهایی ترانسفورماتور مدنظر.

همان طور که دیده می شود سیم پیچ اولیه بر روی یک ساق و سیم پیچ ثانویه بر روی ساق دیگر بسته خواهد شد. هسته های UI اندازه های متفاوت دارند. شکل ۲، اندازه های مختلف هسته های UI و ابعاد آن را به mm نشان می دهد. برای کاربرد ما هسته 180UI مناسب به نظر می رسد. از روی این ابعاد می توانید Lm یا طول متوسط مدار مغناطیسی را تعیین کنید.







شكل ۲: ابعاد مختلف هسته UI. ابعاد به mm است.

80

15

منحنى BH هسته

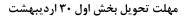
نوع هسته انتخابی از جنس Electrical-Steel-NGO-35PN250 است که مشخصه این به صورت شکل ۳ است. از آنجا که در طول پروژه احتیاج به استفاده از مشخصه این هسته داریم، تلاش کردیم تا به کمک مجموعه است. از آنجا که در طول پروژه احتیاج به استفاده از مشخصه این هسته داریم، تلاش کردیم تا به کمک مجموعه Curve fitting از نرمافزار MATLAB یک تابع ریاضی به مجموعه نشانداده شده برازش کنیم. ما برای برازش تابع نمایی را انتخاب کردهایم. تصاویر ابزار curve fitting و منحنی برازش شده در شکل ۴ نشان داده شده است. بر اساس این شکل، توابع ریاضی که می توانیم از آنها استفاده کنیم به صورت زیر است:

$$B = 1.578 \times \exp(9.69e - 6 \times H) - 1.578 \times \exp(-0.00859 \times H)$$
$$H = 0.1431 \times \exp(6.253 \times B) - 0.1431$$

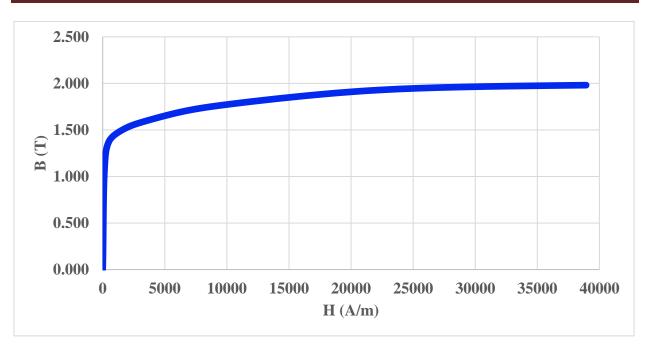
دقت کنید که توابع به نحوی تغییر داده شدهاند که منحنی BH از مبدا عبور کند.

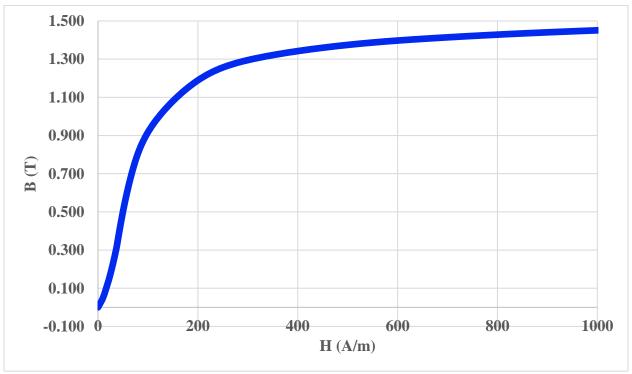


پروژه امتیازی ماشین های الکتریکی ۱





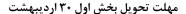




شكل ٣: منحنى BH هسته از جنس BH هسته از جنس



پروژه امتیازی ماشین های الکتریکی ۱







شكل ۴: برازش تابع نمايي به منحني BH هسته.

تعیین تعداد دور سیمپیچ و سطح مقطع هسته

گام اول تعیین مشخصات سیمپیچ اولیه و ثانویه است. از آنجا که تغذیه به صورت ac است میتوانیم از رابطه زیر استفاده کنیم:





$$\varphi = \frac{1}{N} \int v(t)dt = \frac{1}{N} \int V_{\text{max}} \cos(\omega t)dt = \frac{V_{\text{max}}}{N\omega} \sin \omega t$$

بنابراین می توان برای حداکثر شار رابطه زیر را نوشت:

$$\varphi_{\text{max}} = \frac{V_{\text{max}}}{N\omega} \Longrightarrow V_{\text{max}} = N\omega\varphi_{\text{max}}$$

رابطه فوق را می توان بر حسب ولتاژ موثر و چگالی شار به شکل زیر نوشت:

$$V_{\text{max}} = \sqrt{2}V_{rms} = N \times 2\pi f \times B_{\text{max}}A$$

$$V_{rms} = 4.44NfAB_{\text{max}}$$

آخرین رابطه را می توان برای تعیین مشخصات استفاده کرد. در ساختاری که مد نظر ماست در سمت اولیه برای مثال، مقدار ولتاژ موثر مشخص و برابر ۷ 230، فرکانس برابر 50 Hz است. همچنین با توجه به منحنی BH هسته انتخاب چگالی شار برابر T 9.0 در نقطه زانو مناسب به نظر می رسد. بنابراین آنچه که باقی می ماند حاصل ضرب A یعنی سطح مقطع هسته در N یعنی تعداد دور سیم پیچ است. با انتخاب N به نحو دلخواه میزان سطح مقطع مورد نیاز از هسته مشخص خواهد شد. برای یک ترانسفورماتور به شکل بالا انتخاب تعداد دور بین 115 دور تا 460 دور به یک طراحی معقول منجر می شود.

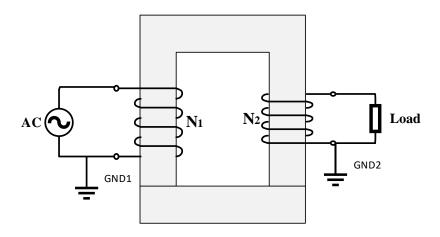
۱) به صورت دلخواه N را انتخاب کرده و سطح مقطع لازم را مشخص و در گزارش قید کنید. همچنین بر اساس مشخصات هسته 180UI طول متوسط هسته را گزارش کنید.

ايجاد مدل ترانسفورماتور

در نسخه جدید سیمولینک، فضای Magnetics ذیل کتابخانه Foundation Library ایجاد شده است که دارای المانهای مختلف برای جابه جایی بین فضای مغناطیسی و الکتریکی است. مداری که بایستی ایجاد شود به شکل زیر است:

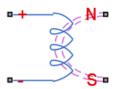






شكل ۵: مدار ترانسفورماتور مورد شبيهسازي.

برای اجزای الکتریکی از مجموعه Electrical ذیل Foundation Library استفاده کنید. برای مدل الکتریکی از مجموعه الوکتانس متغیر استفاده کرد. برای مدل سازی سیمپیچ مدل سازی هسته بایستی در فضای مغناطیسی از یک رلوکتانس متغیر استفاده کرد. و Electromagnetic Converter (EC) با شمای زیر استفاده کرد:



Electromagnetic Converter2

شكل ۶: شماى Electromagnetic Converter

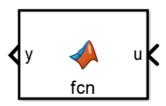
EC در حقیقت مدل یک سیمپیچ است که از یک سمت به فضای الکتریکی و از سمت دیگر با تولید mmf به فضای مغناطیسی متصل میشود. در سمت مغناطیسی برای مدلسازی هسته بایستی یک رلوکتانس با مشخصه BHای که پیش تر برازش کردیم ایجاد کنید.





راهنمایی: همانطور که مقاومت الکتریکی را می توان با یک منبع ولتاژ وابسته به جریان خودش مدل کرد، یک رلوکتانس را می توان با منبع mmf وابسته به شار خودش مدل کرد. در سیمولینک منبع mmf وابسته به شار و همچنین سنسور شار موجود است. رابطه بین شار و mmf تولید شده می تواند به هر شکلی باشد از جمله می تواند رابطه BH برازش شده را داشته باشد. برای ارتباط بین ورودی و خروجی با هر رابطه دلخواه می توانید از MATLAB Function در محیط سیمولینک با شمای زیر استفاده کنید.

MATLAB Function1



پس از مدلسازی رلوکتانس غیرخطی، میتوان یک EC دیگر در سمت دیگر رلوکتانس اضافه کرد تا سیمپیچ دوم ترانسفورماتور را مدل کند. در آمادهسازی مدل به نکات زیر توجه داشته باشید:

- هر دو سمت الکتریکی بایستی دارای زمین باشند وگرنه مدل اجرا نمیشود.
- در سمت مغناطیسی، به یک Magnetic reference که معادل زمین الکتریکی است احتیاج دارید.
- منبع mmf دارای سر مثبت و منفی است. در صورتی که سر مثبت و منفی را اشتباه متصل کنید، یک رلوکتانس منفی مدل میشود و مدل نایایدار خواهد شد.
- فاز منبع ولتاژ اولیه را بر روی 90 درجه تنظیم کنید در غیر این صورت پدیدهای به نام جریان هجومی مدل میشود که مدنظر ما نیست.
 - برای مدلسازی حالت مدار باز می توانید مقاومت Load را بزرگ در نظر بگیرید.
- فضاهای الکتریکی و مغناطیسی جزء فضاهای فیزیکی محسوب میشوند و در نتیجه سیگنال آنها را نمی توان مستقیم به اسکوپ داده و یا یک تابع بر روی آنها پیادهسازی کرد. برای تبدیل سیگنال فیزیکی به سیگنال معمولی سیمولینک بایستی از Simulink-PS converter با شمای زیر استفاده کنید.







Converter1

• همچنین با استفاده از PS-Simulink Converter با شمای زیر می توان یک سیگنال عادی سیمولینک را به یک سیگنال فیزیکی تبدیل کرد:



• برای حل مدار حداقل به یک Solver Configuration با شمای زیر احتیاج دارید که به یک نقطه از مدل مثلا به مدار الکتریکی متصل شده باشد.

• با توجه به اینکه مدار در فرکانس 50 Hz کار می کند، در صورتی که زمان اجرا را طولانی قرار دهید و گامهای حل را بزرگ در نظر بگیرید، مدل به درستی کار نمی کند. شبیه سازی پنج سیکل یعنی حدود 0.1 s

اکنون مدل ترانسفورماتور آماده است و میتوان تحلیلهای متفاوتی بر روی آن انجام داد.





مطالعات و مطالبات

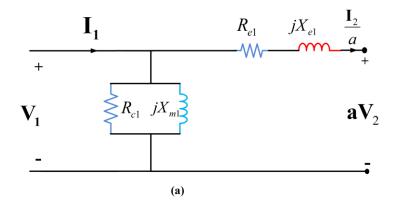
- ۲) در حالتی که ترانسفورماتور بدون بار است (Ω 10000 < 10000) شکل موج شار هسته و همچنین جریان بی باری ترانسفورماتور را گزارش کنید. آیا شکل موج جریان و شار سینوسی است؟ اگر هریک از شکل موجها غیرسینوسی است علت آن را توضیح دهید.
 - ۳) در حالت فوق، مقدار موثر ولتاژ ورودی و خروجی را گزارش کنید. آیا نسبت تبدیل رعایت شده است؟
- ۴) در حالت فوق، مقدار پیک چگالی شار در هسته را مشخص کنید. آیا با مقدار طراحی یعنی T 0.9 همخوانی دارد یا خیر. در غیر این صورت علت آن را توضیح دهید.
- ۵) اکنون برای کامل تر شدن مدل، مقاومتهای سیم پیچ اولیه و ثانویه را در مدار الکتریکی اضافه کنید. مقاومت اولیه را در حدود چند اهم و مقاومت ثانویه را در حد چند صد میلی اهم در نظر بگیرید. مجددا قسمت ۲ را پیاده سازی کنید. آیا شکل موج شار سینوسی است؟ چرا؟
- ۶) اکنون مقدار مقاومت بار را بر روی Ω 10 تنظیم کنید. شکل موج جریان خروجی و ورودی و همچنین شکل موج ولتاژ ورودی و خروجی را گزارش کنید. مقدار موثر ولتاژ ورودی و خروجی را نیز مشخص کنید. آیا شکل موج جریانها سینوسی است؟ چرا؟ آیا نسبت تبدیل رعایت شده است؟ چرا؟
- ۷) برای در نظر گرفتن نشتی شار هر سیمپیچ یک رلوکتانس خطی که نماینده عبور شار در هوا است را با هر سیمپیچ موازی کنید (یک رلوکتانس نشتی موازی سیمپیچ اولیه و یک رلوکتانس نشتی موازی سیمپیچ ثانویه). برای این رلوکتانس هوایی، طول m 0.1 و سطح مقطع m 20.0625 m معقول به نظر می رسد. بار را بر روی مقدار m 10 تنظیم کنید. آیا مقدار موثر ولتاژ ثانویه تغییر می کند؟ چرا؟ در همین حالت آیا مقدار پیک شار در هسته عوض شده است؟ علت آن را قید کنید.
- ۸) اکنون میخواهیم برای ترانسفورماتور شبیهسازی شده یک مدل الکتریکی استخراج کنیم. مدل ارجاع شده به سمت اولیه را به شکل زیر انتخاب می کنیم. با انجام آزمون های مدارباز و اتصال کوتاه بر روی مدلی که ایجاد کرده اید، هر یک از چهار عنصر زیر را تعیین کرده و گزارش کنید. در صوتی که در حالت مدارباز جریان تحریک غیرسینوسی است، هارمونیک اول آن را برای محاسبه مدل در نظر بگیرد. با توجه به مدل محاسبه شده، آیا سلف مغناطیسی ترانسفورماتور با N^2/R که R رلوکتانس غیر خطی مدل شده در نقطه محاسبه شده، آیا سلف مغناطیسی ترانسفورماتور با N^2/R که R رلوکتانس غیر خطی مدل شده در نقطه



پروژه امتیازی ماشین های الکتریکی ۱ مهلت تحویل بخش اول ۳۰ اردیبهشت



کار است تطابق دارد؟ چرا؟ آیا مجموع سلف نشتی با جمع N^2/R_L که در آن R_L رلوکتانس نشتی اضافه شده به صورت موازی با سیمپیچ است تطابق دارد؟ چرا؟



شکل ۷: مدار معادل ترانسفورماتور ارجاعشده به سمت اولیه.

تذكرات:

- لازم است فقط فایل PDF گزارش به همراه فایل MATLAB در سایت درس آپلود نمایید.
 - مهلت آپلود فایل این پروژه تا ساعت ۲۳:۵۵ روز ۳۰ اردیبهشت ماه است.
- پروژه تحویل حضوری دارد که لازم است دانشجویان در زمانی که بعدا مشخص خواهد شد به صورت حضوری به سوالات مرتبط با پروژه پاسخ دهند.
- افرادی که تا زمان مشخص شده فایلهای خود را آپلود نکنند نمیتوانند در تحویل حضوری شرکت نمایند.
- افرادی که فایل های خود را آپلود کرده ولی در تحویل حضوری شرکت نکنند نمرهای دریافت نمیکنند.

موفق باشيد